



XIII Российская конференция по физике полупроводников

Первое информационное сообщение

XIII Российская конференция по физике полупроводников «Полупроводники-2017» будет проходить с **25 по 29 сентября 2017 года** в ФГБУН Институте физики металлов им. М.Н. Михеева УрО РАН (ИФМ УрО РАН), г. Екатеринбург. Эта конференция продолжит традицию предыдущих конференций, которые были проведены в Нижнем Новгороде (1993, 2001, 2011), Санкт-Петербурге (1996, 2003, 2013), Москве (1997, 2005, 2015), Новосибирске (1999), Екатеринбурге (2007), в Новосибирске и Томске (2009).

Сайт конференции

<http://semicond2017.imp.uran.ru/>.

Также информацию о конференции можно найти на официальном сайте ИФМ УрО РАН в разделе научные мероприятия (предстоящие конференции) <http://www.imp.uran.ru/?q=ru/konferencii>

Организаторы конференции

Федеральное агентство научных организаций РФ
ФГБУН Институт физики металлов им. М.Н. Михеева УрО РАН
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
Отделение физических наук РАН
Научный совет РАН по физике полупроводников

Конференцию поддерживают

- Федеральное агентство научных организаций РФ
- Российская академия наук
- Российский фонд фундаментальных исследований
- ФГБУН Институт физики металлов им. М.Н. Михеева УрО РАН
- Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина

Тематика конференции

Конференция посвящена фундаментальным проблемам физики полупроводников. Основные разделы программы:

- 1. Объемные полупроводники:** электрические и оптические свойства, релаксация носителей заряда, сверхбыстрые явления, экситоны, фононы, фазовые переходы, упорядочение.
- 2. Поверхность, пленки, слои:** эпитаксия, атомная и электронная структура поверхности, адсорбция и поверхностные реакции, процессы формирования (самоорганизации) нанокластеров, СТМ и АСМ, оптическая микроскопия ближнего поля.
- 3. Гетероструктуры и сверхрешетки:** структурные и оптические свойства, электронный транспорт, микрорезонаторы.
- 4. Двумерные системы:** структурные, электронные, магнитные и оптические свойства, туннелирование, локализация, фононы, плазмоны, квантовый эффект Холла, корреляционные эффекты.
- 5. Одномерные и нульмерные системы:** энергетический спектр, электронный транспорт, оптические свойства, локализация.
- 6. Спиновые явления, спинтроника, наномagnetизм.**

7. **Примеси и дефекты (объемные полупроводники и квантово-размерные структуры):** примеси с мелкими и глубокими уровнями, магнитные примеси, структурные дефекты, неупорядоченные полупроводники.
8. **Высокочастотные явления в полупроводниках (СВЧ и терагерцовый диапазон).**
9. **Органические полупроводники, молекулярные системы.**
10. **Углеродные наноматериалы.**
11. **Метаматериалы и фотонные кристаллы. Нанопотоника.**
12. **Полупроводниковые приборы и устройства:** технология, методы исследования, наноприборы.
13. **Наномеханика.**
14. **Топологические изоляторы.**

Комитеты

Программный комитет

Е.Л. Ивченко, председатель, ФТИ им. А. Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург
М.М. Глазов, ученый секретарь, ФТИ им. А. Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург
Ж.И. Алферов, СПб АУ НОЦНТ РАН, Санкт-Петербург
А.А. Андронов, ИФМ РАН, Нижний Новгород
А.Л. Асеев, ИФП СО РАН, Новосибирск
В.А. Волков, ИРЭ РАН, Москва
С.В. Гапонов, ИФМ РАН, Нижний Новгород
А.В. Германенко, УрФУ, Екатеринбург
А.А. Гиппиус, ФИАН, Москва
А.А. Горбачев, ФИАН, Москва
А.В. Двуреченский, ИФП СО РАН, Новосибирск
В.С. Днепровский, МГУ, Москва
А.Г. Забродский, ФТИ им. А. Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург
С.В. Зайцев-Зотов, ИРЭ РАН, Москва
А.А. Каплянский, ФТИ им. А. Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург
В.В. Кведер, ИФТТ РАН, Черноголовка
П.С. Копьев, ФТИ им. А. Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург
З.Ф. Красильник, ИФМ РАН, Нижний Новгород
Г.Я. Красников, ОАО «НИИМЭ и «Микрон», Зеленоград
И.В. Кукушкин, ИФТТ РАН, Черноголовка
В.Д. Кулаковский, ИФТТ РАН, Черноголовка
Л.В. Кулик, ИФТТ РАН, Черноголовка
Ю.Г. Кусраев, ФТИ им. А. Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург
А.В. Латышев, ИФП СО РАН, Новосибирск
И.Г. Неизвестный, ИФП СО РАН, Новосибирск
В.И. Окулов, ИФМ УрО РАН, Екатеринбург
В.Я. Покровский, ИРЭ РАН, Москва
А.А. Саранин, ИАПУ ДВО РАН, Владивосток
Н.Н. Сибельдин, ФИАН, Москва
Р.А. Сурис, ФТИ им. А. Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург
А.С. Терехов, ИФП СО РАН, Новосибирск
В.Б. Тимофеев, ИФТТ РАН, Черноголовка
В.В. Устинов, ИФМ УрО РАН, Екатеринбург
В.М. Устинов, ФТИ им. А. Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург
Д.Р. Хохлов, МГУ, Москва
А.В. Чаплик, ИФП СО РАН, Новосибирск
В.И. Шашкин, ИФМ РАН, Нижний Новгород
М.В. Якунин, ИФМ УрО РАН, Екатеринбург

Контакты программного комитета:

Ивченко Еугениус Левович: ivchenko@coherent.ioffe.ru, +7 (921) 986-90-33

Глазов Михаил Михайлович: glazov@coherent.ioffe.ru, +7 (911) 913-04-36

Организационный комитет

М.В. Якунин, *председатель*, ИФМ УрО РАН, Екатеринбург
В.И. Окулов, *заместитель председателя*, ИФМ УрО РАН, Екатеринбург
А.В. Германенко, *заместитель председателя*, УрФУ, Екатеринбург
С.В. Гудина, *ученый секретарь*, ИФМ УрО РАН, Екатеринбург

Ю.Г. Арапов,	ИФМ УрО РАН, Екатеринбург
Б.А. Аронзон	НИЦ «КИ» и ФИАН, Москва
С.Б. Бобин	ИФМ УрО РАН, Екатеринбург
В.А. Волков	ИРЭ РАН, Москва
В.И. Гавриленко	ИФМ РАН, Н. Новгород
Т.Е. Говоркова	ИФМ УрО РАН, Екатеринбург
А.В. Двуреченский	ИФП СО РАН, Новосибирск
В.В. Дерюшкин	ИФМ УрО РАН, Екатеринбург
И.В. Жевстовских	ИФМ УрО РАН, Екатеринбург
В.А. Заяц	ОФН РАН, Москва
Е.В. Ильченко	ИФМ УрО РАН, Екатеринбург
А.С. Клепикова	ИФМ УрО РАН, Екатеринбург
П.С. Копьев	ФТИ РАН, Санкт-Петербург
И.В. Коробейников	ИФМ УрО РАН, Екатеринбург
А.Т. Лончаков	ИФМ УрО РАН, Екатеринбург
А.М. Луговых	ИФМ УрО РАН, Екатеринбург
В.Н. Неверов	ИФМ УрО РАН, Екатеринбург
С.Г. Новокшенов	ИФМ УрО РАН, Екатеринбург
М.Р. Попов	ИФМ УрО РАН, Екатеринбург
А.П. Савельев	ИФМ УрО РАН, Екатеринбург
Н.Н. Сибельдин	ФИАН, Москва
Т.П. Суркова	ИФМ УрО РАН, Екатеринбург
Д.Р. Хохлов	МГУ, Москва
Т.Б. Чарикова	ИФМ УрО РАН, Екатеринбург
Н.Г. Шелушина	ИФМ УрО РАН, Екатеринбург
А.А. Шерстобитов	ИФМ УрО РАН, Екатеринбург

Контакты оргкомитета

620990 Екатеринбург, ул. С.Ковалевской, 18,
ФГБУН Институт физики металлов им. М.Н.Михеева УрО РАН

Якунин Михаил Викторович: (343) 3783644

Окулов Всеволод Игоревич: (343)3745253

Гудина Светлана Викторовна: (343)3783788

факс: (343) 3745244

e-mail: semicond2017@imp.uran.ru

Место проведения

Конференция пройдет в ИФМ УрО РАН, г. Екатеринбург. Размещение участники конференции осуществляют самостоятельно. Организаторы берутся предложить несколько вариантов гостиниц с льготными условиями.

Регистрация участников

Регистрация участников и отправка тезисов будет осуществляться в электронном виде через личный кабинет на сайте конференции <http://semicond2017.imp.uran.ru/> и будет доступна с 23 января 2017 года.

Важные даты

Первое извещение	26 декабря 2016 г.
Начало регистрации и приёма тезисов	23 января 2017 г.
Окончание приёма тезисов	27 марта 2017 г.
Уведомление о принятии доклада	22 мая 2017 г.
Второе извещение	22 мая 2017 г.
Открытие конференции	25 сентября 2017 г.
Закрытие конференции	29 сентября 2017 г.